

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-314785

(43)公開日 平成6年(1994)11月8日

(51)Int.Cl.

H 01 L 29/784
21/265
21/324

識別記号

序内整理番号

F I

技術表示箇所

Z 8617-4M
9056-4M
8617-4MH 01 L 29/ 78
21/ 265

審査請求 未請求 請求項の数 9 FD (全 9 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平5-343945

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所
神奈川県厚木市長谷398番地

(22)出願日 平成5年(1993)12月17日

(72)発明者 須沢 秀臣

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

(31)優先権主張番号 特願平5-71104

(72)発明者 竹村 保彦

(32)優先日 平5(1993)3月5日

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

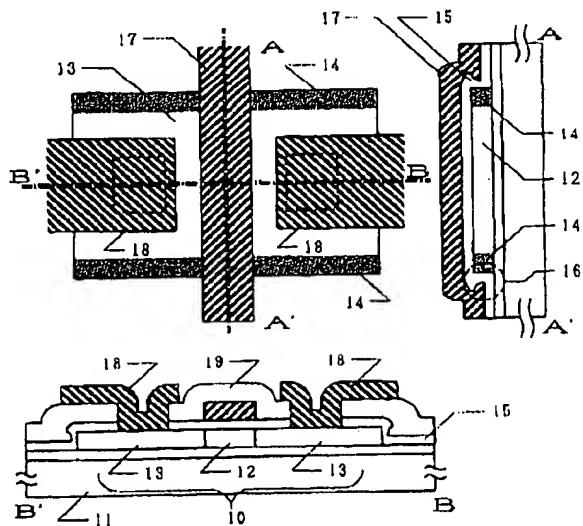
(33)優先権主張国 日本 (JP)

(54)【発明の名称】 薄膜半導体装置およびその作製方法

(57)【要約】

【目的】 薄膜トランジスタにおいて、ゲート電極・配線と薄膜半導体領域（活性層）との間の信頼性を向上させ、特性の改善を図る。

【構成】 薄膜半導体領域の端部、特にゲート電極が横断する部分に不純物領域（ソース、ドレイン）とは逆の導電型を示す不純物を混入させることにより、ソース、ドレイン間のリーキ電流を減少させる。



(2) 特開平6-314785

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁表面を有する基板上に形成された島状の薄膜半導体領域と、前記半導体領域を横断するゲイト電極とを有する薄膜半導体装置において、前記半導体領域の外側周辺部のうち、前記ゲイト電極の下の部分の導電型は、前記半導体領域のソース、ドレイン領域の導電形と逆の導電形であることを特徴とする薄膜半導体装置。

【請求項2】 請求項1において、該島状の薄膜半導体領域はテープー状のエッチを有していることを特徴とする薄膜半導体装置。

【請求項3】 請求項1において、ソース、ドレイン領域の導電型と逆の導電型である領域の幅は、0.05～5μm、好ましくは、0.1～1μmであることを特徴とする薄膜半導体装置。

【請求項4】 請求項1において、島状の半導体薄膜のうち、ソース、ドレイン領域とは逆の導電形を示す部分と実質的に同じ部分に酸素、炭素、窒素のうち、少なくとも1つの元素を有していることを特徴とする薄膜半導体装置。

【請求項5】 島状の薄膜半導体領域を形成する工程と、前記薄膜半導体領域の周辺部のうち少なくともゲイト電極が横断する部分に、ソース、ドレイン領域とは逆の導電形を示す不純物を選択的に導入する工程と、前記薄膜半導体領域を横断してゲイト電極を形成する工程と、前記ゲイト電極をマスクとして自己整合的に前記薄膜半導体領域に不純物を導入してソース、ドレイン領域を形成することを特徴とする薄膜半導体装置の作製方法。

【請求項6】 島状の薄膜半導体領域を実質的にアモルファス状態の半導体材料を用いて形成する工程と、前記薄膜半導体領域の周辺部にソース、ドレイン領域とは逆の導電形を示す不純物を導入する工程と、前記薄膜半導体領域にレーザーもしくはそれと同等な強光を照射して結晶化させる工程と、前記薄膜半導体領域を横断してゲイト電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜半導体装置の作製方法。

【請求項7】 非単結晶半導体薄膜上に直接、もしくは間接にマスク材を形成し、フォトリソグラフィー法によつて、島状にバターニングをおこなう工程と、ドライエッキング法もしくはウェットエッキング法によって、前記マスク材のパターンにしたがつて、前記半導体薄膜を島状にエッチングする工程と、前記島状の半導体薄膜上にマスク材を残した状態で、N型もしくはP型の不純物のイオンを加速して照射する工程と、前記半導体薄膜を横断してゲイト電極を形成する工程とを有することを特徴とする薄膜半導体装置の作製方法。

【請求項8】 請求項7において、該島状の半導体薄膜はテープー状のエッチを有していることを特徴とする薄膜半導体装置の作製方法。

【請求項9】 請求項8において、N型もしくはP型の不純物のイオンを加速して照射する工程の前後、もしくは同時に、島状の半導体薄膜のN型もしくはP型の不純物のイオンの照射された領域と実質的に同じ領域に酸素、炭素、窒素のうち、少なくとも1つの元素を導入する工程を有していることを特徴とする薄膜半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、薄膜集積回路に用いる回路素子、例えば、薄膜トランジスタ（TFT）の構造および作製方法に関するものである。本発明によって作製される薄膜トランジスタは、ガラス等の絶縁基板上、単結晶シリコン等の半導体基板上に形成された絶縁体上、いずれにも形成される。

【0002】

【從来の技術】 従来、薄膜トランジスタは、薄膜半導体領域（活性層）を島状にバターニングして、形成した後、ゲイト絶縁膜として、CVD法やスパッタ法によって絶縁被膜を形成し、その上にゲイト電極を形成した。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 CVD法やスパッタ法で形成される絶縁被膜はステップカバレージ（段差被覆性）が悪く、信頼性や歩留り、特性に悪影響を及ぼしていた。図5には從来の典型的なTFTを上から見た図、およびその図面のA-A'、B-B'に沿った断面図を示す。TFTは基板5-1上に形成され、薄膜半導体領域は不純物領域（ソース、ドレイン領域、ここではN型の導電型を示す）5-3とゲート電極5-7の下に位置し、実質的に真性のチャネル形成領域5-2に分けられ、この半導体領域を覆って、ゲート絶縁膜5-5が設けられる。不純物領域5-3には、層間絕縁物5-9を通してコンタクトホールが開けられ、電極・配線5-8が設けられる。

【0004】 図から分かるように、ゲート絶縁膜5-5の半導体領域の端部における被覆性は著しく悪く、典型的には平坦部の厚さの半分しか厚みが存在しない。一般に島状半導体領域が厚い場合には甚だしい。特にゲート電極に沿ったA-A'断面からこのような被覆性の悪化がTFTの特性、信頼性、歩留りに及ぼす悪影響が分かる。すなわち、図5のA-A'断面図において点線円で示した領域5-6に注目してみれば、ゲート電極5-7の境界が薄膜半導体領域の端部に集中的に印加される。すなわち、この部分ではゲート絶縁膜の厚さが平坦部の半分であるので、その電界強度は2倍になるためである。

【0005】 この結果、この領域5-6のゲート絶縁膜は長時間のあるいは高い電圧印加によって容易に破壊される。ゲート電極に印加される信号が正であれば、この領域5-6の半導体もN型であるので、ゲート電極5-7と不純物領域5-8（特に、ドレイン領域）が導通してしまい、信頼性の劣化の原因となる。また、ゲート電極に通

(3)

特開平6-314785

3
常の電圧とは逆の電圧（Nチャネルトランジスタにおいてはドレインに正、ゲートに負の電圧）を印加した場合に、ソース／ドレイン間に流れる電流（オフ電流）が増大してしまった。典型的には、このオフ電流を減少、できれば $1 \cdot 10^{-12}$ A以下にすることができない。

【0006】また、ゲイト絶縁膜が破壊された際には、何らかの電荷がトラップされることが起こり、例えば、負の電荷がトラップされれば、ゲイト電極に印加される電圧にはほとんど関わりなく、領域5-6の半導体はN型を呈し、ソース／ドレインと同一導電型のバス（通路）ができるしまう。そのため2つの不純物領域5-8が、島状の半導体領域の側周辺部分で電気的に導通することとなり、特性を劣化させる。また、以上のような劣化を引き起こさずしてTFTを使用するには、半分の電圧しか印加しないようにするしかない。しかし、それではTFTの性能を十分に利用することができない。

【0007】また、TFTの一部にこのような弱い部分が存在するということは製造工程における帯電等によって容易にTFTが破壊されることであり、歩留り低下の大きな要因となる。本発明はこのような問題を解決することを課題とする。

【0008】

【発明を解決するための手段】本発明では、このように電気的に弱い領域の半導体をソース、ドレインを構成する不純物領域の導電型と逆にすることによって補うことを特徴とする。そして、その領域を0.05~5 nm、好ましくは0.1~1 μmの幅（上方から見た平坦部での幅）に作ることにより電流リークを抑止することである。本発明の典型的な構造を図1に示す。図1も図5と同様にTFTを上から見た図面と、そのA-A'、B-B'断面の断面図を示している。TFTは基板1-1上に形成され、薄膜半導体領域は不純物領域（ソース、ドレイン領域、ここではNチャネル型TFTであるためN型の導電型を示し、また、外側の周辺部はP型の不純物のホウ素を $1 \times 10^{15} \sim 3 \times 10^{18}$ cm⁻³の濃度に添加した。また、他方、Pチャネル型TFTではP型のソース、ドレインとし、該領域にはN型の不純物を添加する）1-3とゲート電極1-7の下に位置し、実質的に真性のチャネル形成領域1-2に分けられ、この半導体領域を覆って、ゲート絶縁膜1-5が設けられる。不純物領域1-3にL、層間絶縁物1-9を通してコンタクトホールが開けられ、電極・配線1-8が設けられる。

【0009】図5で示した従来のTFTと異なる点は、少なくともゲート電極の下部の島状の半導体領域1-0の周辺部、すなわち領域の外側端部に、不純物領域（ソース、ドレイン領域）1-3の導電形とは逆の導電形の領域1-4を設けたことである。例えば、不純物領域がN型であれば、領域1-4にはP型の導電型を示す不純物を導入し、不純物領域がP型であれば、領域1-4にはN型の導電型を示す不純物を導入する。特に領域1-4の不純物濃

度はゲート電極に印加した電圧によって反転しない程度の十分なドーピング（具体的には $1 \cdot 10^{15} \sim 3 \times 10^{18}$ cm⁻³、好ましくは、 $1 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{17}$ cm⁻³）が望まれる。この不純物濃度が、 $1 \cdot 10^{19}$ cm⁻³またはそれ以上になると、ドレインとの耐圧が弱くなり、アバランシェ・ホット・キャリヤが発生してしまう。なお、ゲート電極の下の部分以外においては、不純物領域1-3のドーピングの際に、領域1-4の導電型が反転してしまうことがあるが、実質的に何ら問題はない。

【0010】この領域1-4の効果に関して、A-A'断面の領域1-6に注目して説明する。従来のTFTの場合と同様に、このような半導体領域の端部におけるゲート絶縁膜の被覆性は良くない。したがって、この部分ではゲート絶縁膜が破壊されて、ピンホールが生じたり、電荷がトラップされたりする。ピンホールが生じた場合を考える。従来であれば、ゲート電極に印加された電圧によってチャネル形成領域1-2のうち、領域1-6の部分も不純物領域1-3と同じ導電型に変化しているのであるが、本発明においては、この領域1-4は不純物領域とは逆の導電型にドーピングされているので、ゲート電極に電圧が印加されても導電形が反転しないか、少なくとも良好な導電性を示さない。

【0011】このため、特にゲート電極とドレイン領域間のリーク電流を著しく低減せしめることができる。また、ゲート絶縁膜の破壊によって好ましくない電荷がトラップされた場合においても、領域1-6では半導体領域の導電型が不純物領域のものと同じではないので、ソース領域とドレイン領域が導通することは防止できる。このようにゲート絶縁膜が破壊されても特性や信頼性に問題が生じないのであれば、使用時の電圧の制限は少なくて、また、製造時の静電破壊等による不良品の発生の確率も低下し、歩留りが向上する。

【0012】図1においては薄膜半導体領域のゲート電極の横断する側の端部全てに不純物領域1-3とは逆の導電形の領域1-4を設けた様子を示したが、このような領域は少なくともゲート電極の下の領域に設ければ十分であることは、以上の説明から明らかであろう。また、領域1-4には、上記P型（もしくはN型）不純物以外に、炭素、窒素、酸素等を添加すると、領域1-4の抵抗が増加するため、一層、耐圧が向上し、信頼性の高いTFTが得られた。以下に実施例を示し、さらに本発明を説明する。

【0013】

【実施例】

【実施例1】 図2に本実施例の作製工程の断面図を示す。本実施例を含めて、以下の実施例の図面では、TFTの断面図のみを示し、いずれも左側にはゲート電極に垂直な面（図1、図5の断面B-B'に相当）を有するTFTを構成し、また、右側にはゲート電極に平行な面（図1、図5の断面A-A'に相当）を有するTFTを

(4)

特開平6-314785

6

構成する例を示す。

【0014】まず、基板（コーニング7059）20上にプラズマCVD法またはスパッタリング法によって厚さ2000Åの酸化珪素または窒化珪素、あるいはそれらの多層膜の下地膜21を形成した。さらに、プラズマCVD法によって、厚さ300～1500Å、例えば1000Åのアモルファスシリコン膜を堆積した。連続して、スパッタリング法によって、厚さ200Åの酸化珪素膜を保護膜として堆積した。そして、これを還元雰囲気下、600°Cで48時間アニールして結晶化させた。結晶化工程はレーザー等の強光を用いる方式でもよい。そして、得られた結晶シリコン膜をバーニングして、島状シリコン領域22a、22bを形成した。島状シリコン膜の上には保護膜23a、23bがそれぞれ乗っている。この保護膜は、その後のフォトリソグラフィー工程において、島状シリコン領域が汚染されることを防止する作用がある。

【0015】次に全面にフォトレジストを塗布して、公知のフォトリソグラフィー法によって、レジスト24a、24bを残してバーニングし、その幅は0.05～5μm、好ましくは0.1～1μmの幅に形成した。そして、このレジストをマスクとしてホウ素を $1 \times 10^{15} \sim 3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、好ましくは $1 \cdot 10^{16} \sim 1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ の濃度で導入した。ホウ素の導入にはプラズマドーピング法を用いた。ドーピングガスとしてはジボラン（B₂H₆）を用い、rfパワー10～30W、例えば10Wで放電させてプラズマを発生させ、これを加速電圧20～60kV、例えば20kVで加速して、シリコン領域に導入した。ドーズ量は、 $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 、例えば、 $3 \cdot 10^{14} \sim 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ とした。この結果、P型の領域25a、25b、25c、25dを形成した。（図2（A））

【0016】次に、スパッタリング法またはプラズマCVD法によって厚さ500～1500Å、例えば1000Åの酸化珪素膜26をゲート絶縁膜として堆積し、引き続いて、減圧CVD法によって、厚さ6000～8000Å、例えば6000Åのシリコン膜（0.1～2%の擦を含む）を堆積した。なお、この酸化珪素とシリコン膜の成膜工程は連続的におこなうことが望ましい。そして、シリコン膜をバーニングして、配線27a、27bを形成した。これらの配線は、いずれもゲート電極として機能する。（図2（B））

【0017】次に、プラズマドーピング法によって、シリコン領域に配線27aをマスクとして不純物（擦）を注入した。ドーピングガスとして、フォスフィン（PH₃）を用い、加速電圧を60～90kV、例えば80kVとした。ドーズ量は $1 \times 10^{15} \sim 8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 、例えば、先のホウ素のドーズ量よりも大きい $5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ とした。その後、還元雰囲気中、600°Cで48時間アニールすることによって、不純物を活性化させ

た。このようにして不純物領域28a、28bを形成した。この場合には、先に形成されたホウ素領域のうち、後から擦が導入されなかった領域25c、25dはP型を示すのにに対し、擦が導入された領域25a、25bは多量の擦のドーピングによってN型になっているが、本発明の技術思想からは何ら問題はない。（図2（C））

【0018】続いて、厚さ3000Åの酸化珪素膜を槽間絶縁物としてプラズマCVD法によって形成し、これにコンタクトホールを形成して、金属材料、例えば、窒化チタンとアルミニウムの多層膜によって配線29a、29bを形成した。配線29aは配線27bと上下の不純物領域の一方28bを接続する。以上の工程によって半導体回路が完成した。（図2（D））

【0019】〔実施例2〕 図3に本実施例の作製工程の断面図を示す。基板（コーニング7059）301の絶縁表面上にスパッタリングによって厚さ2000Åの酸化珪素の下地膜302を形成した。さらに、プラズマCVD法によって、厚さ500～1500Å、例えば1000Åのアモルファスシリコン膜を堆積した。連続して、スパッタリング法によって、厚さ200Åの酸化珪素膜を保護膜として堆積した。そして、これを還元雰囲気下、600°Cで48時間アニールして結晶化させた。結晶化工程はレーザー等の強光を用いる方式でもよい。そして、得られた結晶シリコン膜を公知のフォトリソグラフィー法によってバーニングして、島状シリコン領域303a、303bを形成した。島状シリコン膜の上には保護膜が残されている。また、エッチングに用いたフォトレジストのマスク304a、304bも残されている。なお、このエッチング工程においては等方エッチング法（例えば、緩衝フッ酸によるウェットエッチング）を用い、半導体領域の側端部を図に示すようにギヤバー状とした。この角度は基板表面については30°～60°を有せしめた。この面では半導体領域303aはTFTとし、また、半導体領域303bは他の回路であるキャッシュとした。

【0020】次に、このレジストをマスクとしてホウ素を導入した。ホウ素の導入にはプラズマドーピング法を用いた。ドーピングガスとしてはジボラン（B₂H₆）を用い、加速電圧20～60kV、例えば20kVで加速して、シリコン領域に導入した。ドーズ量は、 $1 \cdot 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ 、例えば、 $1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ とした。この結果、P型の領域305a、305b、305c、305dを形成した。（図3（A））

【0021】次に、スパッタリング法によって厚さ1000Åの酸化珪素膜306をゲート絶縁膜として堆積し、引き続いて、スパッタリング法によって、厚さ4000～8000Å、例えば6000Åのアルミニウム膜（0.2重量%のスカンジウムを含む）を堆積した。なお、この酸化珪素とアルミニウム膜の成膜工程は連続的におこなうことが望ましい。そして、アルミニウム膜をハタニ

(5)

特開平6-314785

7

ニングして、配線307a、307bを形成した。これらの配線は、いずれもゲイト電極として機能する。さらに、このアルミニウム配線の表面を陽極酸化して、表面に酸化物層309a、309bを形成した。陽極酸化の前に感光性ポリイミド(フォトニース)によって後でコントラクトを形成する部分にマスク308を選択的に形成した。陽極酸化の際には、このマスクのために、この部分には陽極酸化物が形成されなかった。

【0022】陽極酸化は、酒石酸の1～5%エチレングリコール溶液中でおこなった。得られた酸化物層の厚さは2000Åであった。次に、プラズマドーピング法によって、シリコン領域に配線307aおよび酸化物309aをマスクとして不純物(隕)を注入した。ドーピングガスとして、フロスフィン(PIII)を用い、加速電圧を60～90kV、例えば80kVとした。ドース量は $1 \times 10^{15} \sim 8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 、例えば、先のホウ素のドーズ量よりも大きい $5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ とした。このようにしてN型の不純物領域310a、310bを形成した。この際には、実施例1の場合と同様に先に形成されたホウ素のドーピングされた領域305a、305bはN型に転換している。(図3(B))

【0023】その後、レーザーアニール法によって不純物の活性化をおこなった。レーザーとしてはKrFエキシマーレーザー(波長248nm、バルス幅20nsec)を用いたが、他のレーザー、例えば、XeFエキシマーレーザー(波長353nm)、XeClエキシマーレーザー(波長308nm)、ArFエキシマーレーザー(波長193nm)等を用いてもよい。レーザーのエネルギー密度は、200～350mJ/cm²、例えば250mJ/cm²とし、1cm²につき2～10ショット、例えば2ショット照射した。レーザー照射時に、基板を200～450℃程度に加熱してもよい。基板を加熱した場合には最適なレーザーエネルギー密度が変わることに注意しなければならない。なお、レーザー照射時にはポリイミドのマスク308を残しておいた。これは露出したアルミニウムがレーザー照射によってダメージを受けるからである。レーザー照射後、このポリイミドのマスクは酸素プラズマ中にさらすことによって簡単に除去できる。

【0024】なお、本実施例では、実施例1の場合と異なり、ゲイト電極の下のホウ素の注入された領域305c、305dはレーザー光が入射しないので、活性化率が低いが、イオンの注入の際に結晶性が破壊されているので極めて大きな抵抗として機能し、リーク電流を低下させる目的では効果的であった。(図3(C))

しかし、他方、図3(A)にてテーパー状の側端部を有する島状領域を作り、その後、ホウ素をイオン注入して形成した。さらに、レーザー光を50～350mJ/cm²で照射し、島状領域の全てを結晶化せしめた。すると、側端部はP型化し、内部はI型の真性または実質的

に真性の導電型を有せしめて、さらに前記した如く、ゲイト絶縁膜、ゲイト電極、ソース／ドレインを形成すればよい。かくすると、ゲイト電極下の島状領域端部も十分結晶化されたり、もしくはP型領域とができる、N型のソース／ドレイン間のリークを防ぐことができる。

【0025】続いて、厚さ3000Åの酸化珪素膜311を層間絶縁物としてプラズマCVD法によって形成し、これにコントラクトホールを形成して、金属材料、例えば、窒化チタンとアルミニウムの多層膜によって配線312a、312bを形成した。配線312aは配線307bとTFTの不純物領域の一方310bを接続する。以上の工程によってTFT313a(図ではゲイト電極に垂直な断面)および313b(図ではゲイト電極に平行な断面)が完成した。(図3(D))

なお、本実施例において、TFTのソースもしくはドレインの電極のいずれかを設けなければゲイト電極と残りの不純物領域の間にキャバシタが形成されることは明らかであろう。したがって、本実施例と同等な手段を用いても、耐圧が高い、リークが少ない等の優れた特性を信頼性を有するキャバシタが得られる。そして、このようにして形成したTFTおよびキャバシタを用いてアクティブラズマトリックス型液晶ディスプレーの画素回路を構成してもよい。本発明のTFTにより、オフ電流を1mA未満またはそれ以下とすることができ、十分な機能を有せしめることができた。

【0026】(実施例3) 図4に本実施例の作製工程の断面図を示す。基板(コーニング7059)40上にスパッタリングによって厚さ2000Åの酸化珪素の下地膜41を形成した。さらに、プラズマCVD法によって、厚さ500～1500Å、例えば1500Åのアモルファスシリコン膜を堆積した。そして、得られたアモルファスシリコン膜をバーニングして、島状シリコン領域42a、42bを形成した。

【0027】次に全面にワットレジストを塗布して、公知のフォトリソグラフィー法によって、レジスト43a、43bを残してバーニングした。そして、このレジストをマスクとしてホウ素を導入した。ホウ素の導入にはプラズマドーピング法を用いた。この結果、P型の領域44a、44b、44c、44dを形成した。(図4(A))

【0028】次にアモルファリストを残したまま、スパッタ法によって厚さ1000Åの酸化珪素膜45aを堆積した。(図4(B))

そして、ワットレジストを剥離することによって、その上に形成されていた酸化珪素膜まで除去した。ワットレジストの存在していなかった部分にはそのまま酸化珪素膜が残る。これを還元雰囲気下、600℃で48時間アニールして結晶化させた。結晶化工程はレーザー等の強光を用いる方式でもよい。

(6)

特開平6-314785

【0029】次に、スパッタリング法によって厚さ1000Åの酸化珪素膜45bをゲイト絶縁膜として堆積し、引き続いて、減圧CVD法によって、厚さ6000～8000Å、例えば6000Åのシリコン膜(0.1～2%の燐を含む)を堆積した。なお、この酸化珪素とシリコン膜の成膜工程は連続的におこなうことが望ましい。そして、シリコン膜をバーニングして、配線46a、46bを形成した。これらの配線は、いずれもゲイト電極として機能する。また、島上シリコン領域の周辺部(先にホウ素が注入された領域)に注目すると、ここでは絶縁膜の厚さが酸化珪素45aおよび45bによって、約2倍になっている。そのため、ゲイト絶縁膜の破壊を防ぐ上で効果的である。(図4(C))

【0030】次に、プラズマドーピング法によって、シリコン領域に配線46aをマスクとして不純物(燐)を注入した。ドーピングガスとしては、フォスフィン(PH₃)を用いた。その後、還元雰囲気中、600°Cで48時間アニールすることによって、不純物を活性化させた。このようにして不純物領域47a、47bを形成した。続いて、厚さ3000Åの酸化珪素膜48を層間絶縁物としてプラズマCVD法によって形成し、これにコントラクトホールを形成して、金属材料、例えば、窒化チタンとアルミニウムの多層膜によって配線49a、49bを形成した。配線49aは配線46bとTFTの不純物領域の一方47bを接続する。以上の工程によって半導体回路が完成した。(図4(D))

本実施例によって、歩留りが従来の2倍以上に改善された。また、TFTの特性の悪化は特に認められなかつた。逆に使用に耐えうる最大電圧が従来の1.5～2倍に上昇したために、最高動作速度が2～4倍上昇した。

【0031】【実施例4】図6に本実施例を示す。まず、基板60上に厚さ1000～3000Åの酸化珪素の下地膜61を形成した。さらに、プラズマCVD法やLPCVD法によってアモルファスシリコン膜を100～5000Å、好ましくは300～1000Å堆積した。アモルファスシリコン膜上には保護膜として、酸化珪素膜を100～500Å堆積した。そして、公知のフォトリソグラフィー法によってレジストのマスク63a、63bを形成し、ドライエッチング法によって、アモルファスシリコンのエッティングをおこなった。このときのコントロール条件は、以下のようなであつた。

R.F.パワー	: 500W
圧力	: 100mTorr
ガス流量	
CF ₄	: 50sccm
O ₂	: 45sccm

【0032】この結果、図6(A)に示すように、島状のシリコン領域62a、62bが得られたが、そのエッヂ部は図のようにテーパー状になっていた。このテーパーの角度は20～60°であった。エッティングにおい

10

て、比率CF₄/O₂が大きくなると、このようなテーパー状のエッヂを得ることはできなかつた。次に、このレジストをマスクとしてホウ素を導入した。窒素の導入にはプラズマドーピング法を用いた。ドーピングガスとしてはジボラン(B₂H₆)を用い、加速電圧20～60kV、例えば20kVで加速して、シリコン領域に導入した。ドーズ量は、1×10¹⁴～5×10¹⁶cm⁻²、例えば、1×10¹⁵cm⁻²とした。この結果、レジストがなかつた、もしくは、薄かつたシリコン領域のエッヂ部64a、64b、64c、64dに選択的にホウ素がドーピングされた。(図6(A))

さらに、プラズマドーピング法によって、連続的に窒素をドーピングした。ドーピングガスとしては窒素(N₂)を用い、加速電圧20～60kV、例えば20kVで加速して、シリコン領域に導入した。ドーズ量は、1×10¹⁴～5×10¹⁶cm⁻²、例えば、1×10¹⁴cm⁻²とした。この結果、シリコン領域のエッヂ部64a、64b、64c、64dに窒素がドーピングされた。

【0033】その後、フォトレジストのマスク材63a、63bと、その下の保護膜を除去し、島状のシリコン膜を露出させた状態で、KrFエキシマーレーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照射して、アモルファスシリコンの結晶化をおこなつた。レーザーとしては、XeClエキシマーレーザー(波長308nm、パルス幅50nsec)を用いてもよかつた。その後、スパッタ法もしくはプラズマCVD法によって、厚さ1000～1500Åの酸化珪素膜65を形成し、引き続き、厚さ1000Å～3μmのアルミニウム(1wt%のSi)、もしくは0.1～0.3wt%のSc(スカンジウム)を含む膜を電子ビーム蒸着法もしくはスパッタ法によって形成した。

【0034】そして、その表面に公知のスピニコート法によってフォトレジストを塗布し、公知のフォトリソグラフィー法によって、バーニングをおこなつた。そして、構成によって、アルミニウム膜のエッティングをおこなつた。このようにして、ゲイト電極・配線66a、66bを形成した。なお、ゲイト電極・配線上にはフォトレジストのマスク67a、67bをそのまま残存させておいた。また、オーバーコートのために、ゲイト電極・配線の側面はフォトレジストの側面よりも内側にある(図6(B))。

【0035】この状態で、プラズマドーピング法によって、TFTの活性半導体層62a、62bに、フォトレジスト67a、67bをマスクとして不純物(燐)を注入し、N型のソース68a、ドレイン68bを形成した。ここで、フォトレジスト67aに対して、ゲイト電極66aは距離Nだけ内側にあるため、図に示したように、ゲイト電極とソース・ドレインが重ならないオーバット状態となつてゐる。距離Nは、アルミニウム配線の

(7)

特願平6-314785

11

際のエッティング時間を加減することによって増減できる。xとしては、0.3~5μmが好ましかった。(図6(C))

【0036】その後、フォトレジスト67a、67bを剥離し、KrFエキシマーレーザー(波長248nm、パルス幅20nsec)を照射して、活性層中に導入された不純物イオンの活性化をおこなった。(図6(D))

最後に、全面に層間絶縁物69として、プラズマCVD法によって酸化珪素膜を厚さ2000Å~1μm形成した。さらに、TFTのソース68a、ドレイン68bにコンタクトホールを形成し、アルミニウム配線70a、70bを2000Å~1μm、例えば5000Åの厚さに形成した。このアルミニウム配線の下にバリヤメタルとして、例えば窒化チタンを形成するとより一層、信頼性を向上させることができた(図6(E))。

【0037】

【発明の効果】本発明によって、薄膜半導体素子の歩留りを向上させ、また、その信頼性を高め、最大限を特性を引き出すことが可能となった。本発明の薄膜半導体素子は、特に、ゲートドレイン間、ゲートソース間のリーク電流が低く、高いゲート電圧にも耐えられる等の特徴から液晶ディスプレーのアクティブラトリックス回路における画素制御用のトランジスタとして好ましい。

【0038】本発明ではNチャネル型のTFTを例にとって説明したが、Pチャネル型TFTや同一基板上にNチャネル型とPチャネル型の混在した捕獲型の回路の場合も同様に実施できることは言うまでもない。また、実施例に示したような簡単な構造のものばかりではなく、

例えば、特願平5-256567に示されるようなソース/ドレインにシリサイドを有するような構造のTFTに用いてもよい。また、本実施例はTFTを主として示した。しかし、他の回路素子、例えば、1つの島状領域に複数のゲート電極を有せしめた溝膜集積回路、スタッフゲート型TFT、ダイオード、抵抗、キャパシタ、またはこれを集積化した薄膜半導体回路に応用することが可能であることは言うまでもない。このように本発明は工業上、有益な発明である。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の薄膜半導体装置(TFT)の構成例を示す。

【図2】 実施例1のTFTの作製工程断面を示す。

【図3】 実施例2のTFTの作製工程断面を示す。

【図4】 実施例3のTFTの作製工程断面を示す。

【図5】 従来の薄膜半導体装置(TFT)の構成例を示す。

【図6】 実施例4のTFTの作製工程断面を示す。

【符号の説明】

20 10...島状半導体領域

11...基板

12...チャネル形成領域(実質的に真性)

13...不純物領域(ソース、ドレイン)

14...ドーピング領域(不純物領域とは逆の溝型の不純物を含む)

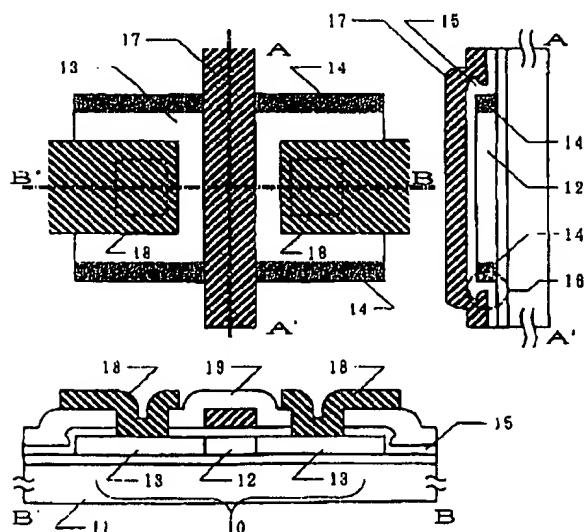
15...ゲート絶縁膜

16...島状半導体領域の端部

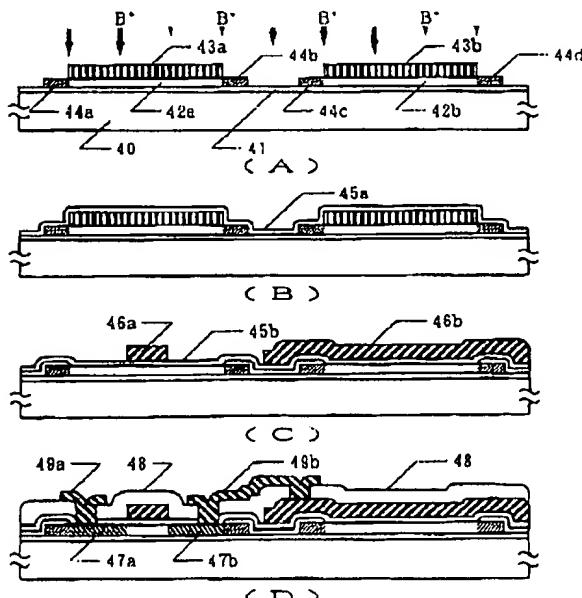
17...ゲート電極

18...ソース、ドレイン電極

【図1】



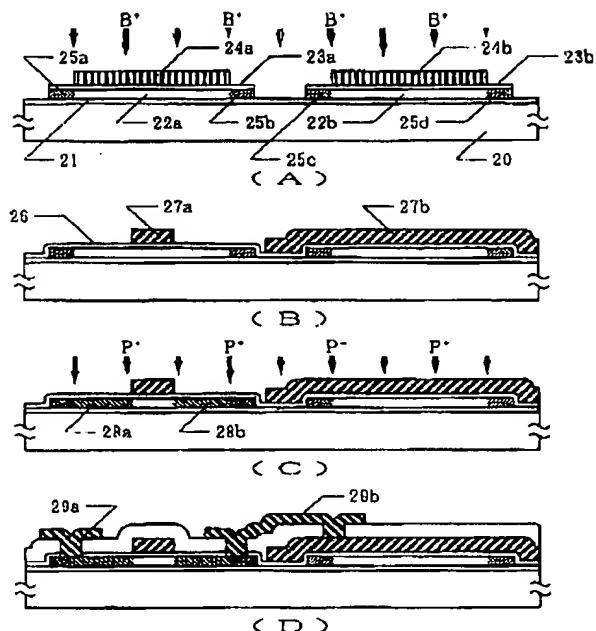
【図4】



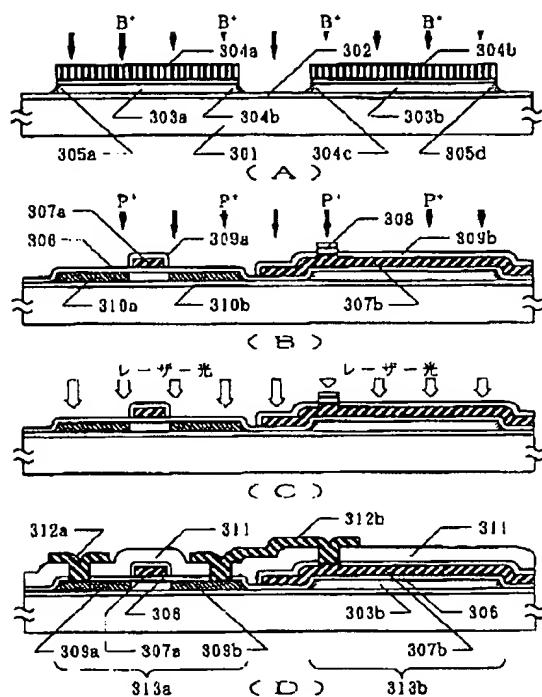
(8)

特開平6-314785

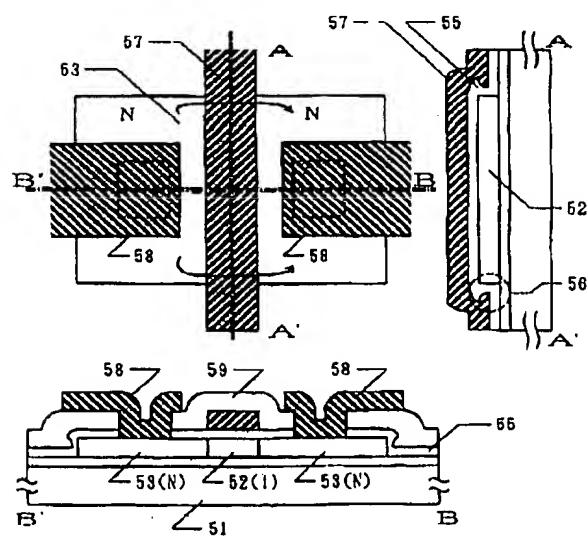
【図2】



【図3】



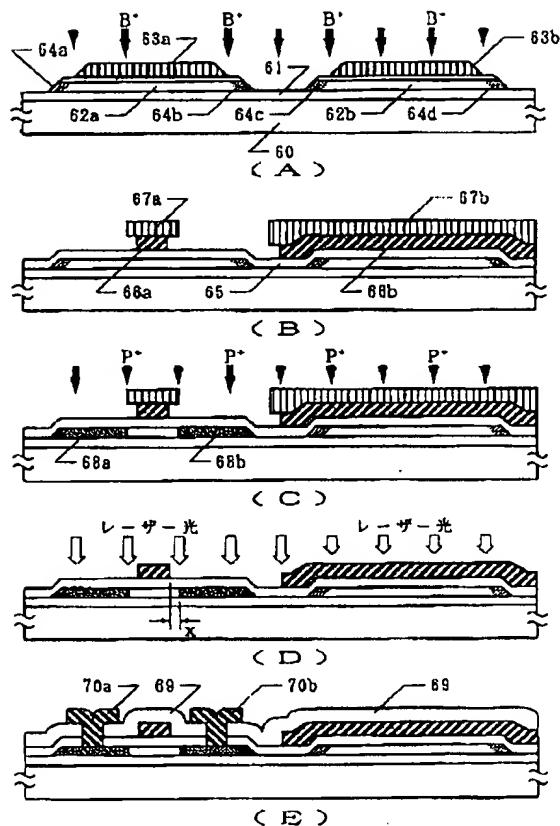
【図5】



(9)

特開平6-314785

【図6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号

府内整理番号

F I

技術表示箇所

8617-4M H 0 1 1. 21/265 S

9056-4M 29/78 3 1 1 S

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.